科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 28年 5月 27 日現在

機関番号: 11301				
研究種目: 若手研究(B)				
研究期間: 2014 ~ 2015				
課題番号: 2 6 8 2 0 3 3 2				
研究課題名(和文)溶融塩電解によるニッケル基超合金の二珪化モリブデンコーティング				
研究課題名(英文)MoSi2 coating on nickel based super alloys by using molten salt electrolysis				
们田 修(Takeda, Usamu)				
東北大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授				
研究者番号:60447141				
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円				
交刊決定額(研究期間主体):(且按詮算) 3,100,000円				

研究成果の概要(和文):本研究では、高温でも機械的・化学的に安定な耐酸化性被膜で超合金を被覆することによって、耐酸化性を飛躍的に向上させることを目標とした。具体的には、溶融塩電解による二珪化モリプデン(MoSi2)被膜の形成を検討した。特に、溶融塩中でのイオンの輸送速度と電極反応の速度、合金中の元素の拡散速度を見積もることによって、機械的・化学的に安定で緻密な厚膜を形成するのに適した電解条件を明らかにした。

研究成果の概要(英文): In this study, the improvement of oxidation-resistance of nickel based super alloys was investigated by coating the super alloys with a mechanically and chemically stable oxidation-resistant film at high temperature. Concretely, the formation of MoSi2 film by using molten salt electrolysis was investigated. By estimating the transportation rate of ions in molten salt, the rate of electrode reaction, and the rate of atomic diffusion in alloys, the electrolytic condition for the formation of a dense and thick film with a mechanical and chemical stability was revealed.

研究分野: 金属生産工学

キーワード: 溶融塩電解 ニッケル基超合金 二珪化モリブデン コーティング

1.研究開始当初の背景

現在、ジェットエンジンや火力発電機のタ ービンブレードに用いられている Ni 基超合 金は、組成や凝固法の改良により耐用温度が 著しく向上し、1100 に達している。しかし、 さらなる省エネルギーや CO₂ の削減のため に、耐用温度の一層の向上が求められている。 一方で、Ni 基超合金の高温強度を増大させる ために Re、W、Mo等の強化元素を添加する と、耐酸化性が低下する問題があり、強化元 素の添加には限界がある。¹⁾

2.研究の目的

本研究では、高温でも機械的・化学的に安 定な耐酸化性被膜で超合金を被覆すること によって、耐酸化性を飛躍的に向上させるこ とを目標とした。具体的には、溶融塩電解に よる二珪化モリプデン(MoSi2)被膜の形成 を検討した。特に、溶融塩中でのイオンの輸 送速度と電極反応の速度、合金中の元素の拡 散速度を見積もることによって、機械的・化 学的に安定で緻密な厚膜を形成するのに適 した電解条件を明らかにすることを目標と した。

3.研究の方法

(1) 溶融塩中でのイオンの輸送速度と電極反 応速度、合金中の元素の拡散速度の見積

真空下であらかじめ乾燥した LiF、KF を Ni 坩堝に装入し、Ar バブリングを行いなが ら 1223 K で溶融・混合し、電解浴となる LiF-49.8 mol% KF 共晶塩を作製した。Mo 電析では、作用極(カソード)に Ni(純度 99.5%)、対極、擬似参照極に Mo(純度 99.5%) を用い、電解浴には共晶塩に 2~10 mol%の K2MoO4と1~5 mol%のK2B4O7を添加して 用いた。Si 電析では、作用極(カソード)に Mo(純度 99.5%)、対極、擬似参照極に Si (純度 99.9999%)を用い、電解浴には共晶 塩に1mol%のK₂SiF₆を添加して用いた。あ らかじめ調製した電解浴をNi 坩堝に装入し、 さらにステンレス鋼(SUS 310S) 製反応管 に設置し、Ar 気流下で昇温し溶融させた。実 験温度は Mo 電析では 1023~1223 K、 Si 電析では 973~1223 K とした。電極を溶 融塩に浸漬し、電気化学測定(Cyclic Voltammetry: CV)および定電流電解を実施 した。電解後のカソードの表面形態、析出物 を SEM-EDX、XRD で分析した。基礎検討 を基に、 Ni 基超合金 (CMSX-4) への Mo 電析、続く Si 電析を試みた。

(2) 平滑かつ緻密な皮膜を形成できる条件の 探査

電気化学測定 真空下であらかじめ乾燥 した LiF、KF を Ni 坩堝に装入し、Ar バブ リングを行いながら 1223 K で溶融・混合し、 電解浴となる LiF-49.8 mol% KF 共晶塩(以 後、FLiK と表記)を調製した。グラッシー カーボン棒(φ2 mm)を作用極、グラファイ ト棒 ($\phi 6 \text{ mm}$)を対極および参照極として用 いた。FLiK に、Mo 源として K₂MoO₄を1 mol%となるように、あるいは B 源として K₂B₄O₇を 0.5 mol%となるように、さらに両 方を添加した。Ar 雰囲気下で塩を加熱、溶融、 1223 K に保持し、電極を浸漬してサイクリ ックボルタンメトリー(CV,走査速度 200 mV·s⁻¹)を行った。

定電流電解による Mo 電析 Ni 板(10x5x2 mm)をカソード、Mo 板(10x10x2 mm, カ ソードを挟むように 2 枚配置)をアノード、 Mo 棒(\$\operatorname{2} mm)を参照極として用いた。電 解浴は、FLiK に K2MoO4を10 mol%となる ように、さらに B 源として K2B4O7を0.01~ 5 mol%となるように添加した。電気化学測定 と同様に1223 K に保持し、電極を浸漬して 定電流電解(カソード電流密度 5~50 mA cm²)を行った。電解後のカソードは、 純水で付着塩を洗浄、除去し、表面形態、析 出物を SEM-EDX、XRD、ICP-AES、GD-OES で分析した。試料の粒界を観察する際は、過 酸化水素 - アンモニア水溶液でエッチング を行った。

4.研究成果

(1) 溶融塩中でのイオンの輸送速度と電極反 応速度、合金中の元素の拡散速度の見積 Mo 電析

Mo 電析浴における Ni 電極の CV では、単 一の還元電流ピークが観測された。Mo は溶 融塩中の複数の価数を取りうるが、本測定か らは式(1)に示す 1 段階の反応が起こったと 考えられた。

$$Mo (VI) + 6e = Mo$$
(1)

10 mol% K₂MoO₄- 5 mol% K₂B₄O₇浴で、カ ソード電流密度 30 mA·cm⁻² で定電流電解 (8.4 ks)を実施したところ、1023 K ではほ とんど Mo が析出しなかったが(電流効率約 25%) 1223 K では Ni カソードに密着性が 良く均一な Mo 被膜が形成された(電流効率 約 97%)。これは、温度の上昇によって浴中 のモリブデン酸イオンの物質輸送が促進さ れたためと考えられた。また、1223 K にお いて溶質濃度を 2 mol% K₂MoO₄- 1 mol% K₂B₄O₇ とした場合、ほとんど Mo が析出し なかっため(電流効率約 8%) 溶質濃度が高 い方が電解に有利であることがわかった。

静止浴において100 mA·cm⁻²で定電流電解 を実施したところ、Mo はデンドライト状に 析出したが、Ar バブリングで電解浴を撹拌す ることでデンドライトの析出は抑制された。 このことから、本電解浴では電極近傍でモリ ブデン酸イオンの欠乏が生じやすいと考え られる。1223 K において、Ar バブリングを 行いながら、50 mA·cm⁻²で定電流電解をして 得られた Mo 層の厚みを**図1**に示す。図中の 点線は、与えた電気量が全て Mo の析出に用 いられた場合の Mo 層の厚み(計算値)を示 している。図より、電解時間の増加と共に線 形に膜厚は増加し、計算値とほぼ一致してい ることがわかる。Mo 層の形成速度は約 0.46 µm·min⁻¹であった。



図 1 1223 K における LiF-KF-10 mol% K₂MoO₄- 5 mol% K₂B₄O₇中での定電流電解 によって Ni カソード上に析出した Mo 層の 厚さ。カソード電流密度: 50 mA·cm⁻².

Si 電析

Si 電析浴における Mo 電極の CV でも、単 ーの還元電流ピークが観測された。式(2)に 示す1段階の反応が起こっていると考えられ た。

Si (IV) + 4e = Si (2)

1073 K において、カソード電流密度 50 mA·cm⁻²で定電流電解を実施したところ、電 位は、電解初期は一定で、その後、約 0.13 V 低下したのち再度一定になる二段階の推移 を示した。平衡論的には、MoSi2の析出電位 は Si の析出電位より約 0.15 V 高いため²⁾、 電解初期には MoSi2 が形成され、電解中期~ 後期には Si が析出していたと考えられる。実 験後、カソードを XRD および SEM-EDX で 分析することによって、MoSi2 単相が形成し たと共に、最表面へ Si が析出していることが 確認された。電流密度を上げると Si の堆積が 顕著になった。これは、電極内部への Si の拡 散に対して Si の析出速度が相対的に速く、 Mo との合金化に供されることなく最表面に 積層していったためと考えられる。浴温を 1223 K まで上げると、MoSi2の生成効率が低 下した。原因は明らかでないが、低温の方が Si電析に有利であることがわかった。

50 mA·cm⁻² で定電流電解をして得られた MoSi₂層の厚みを**図2**に示す。図中の点線は、 与えた電気量が全て MoSi₂ の析出に用いら れた場合の MoSi₂層の厚み(計算値)を示し ている。図より、厚みが 100 μm 程度までは 電解時間の増加と共に線形に膜厚が増加し、 計算値とほぼ一致するが、それ以上の膜厚に なると計算値から大きくずれることがわか った。これも、ある程度の膜厚になるとMoSi2 層中のSiの内方拡散が追い付かず、膜厚成長 が停滞するためと考えられる。



図2 1073 Kにおける LiF-49.3 mol% KF-1 mol% K₂SiF₆中での定電流電解によって Mo カソード上に生成した MoSi₂層の厚さ。カソ ード電流密度: 50 mA·cm⁻².

CMSX-4 への二段階コーティング 基礎検討を基に、CMSX-4 に Mo 電析した (50 mA·cm⁻²、1223 K)後の試料断面を**図3** (a) に、さらに Si 電析した(30 mA·cm⁻²、1073 K)後の試料断面を**図3(b)**に示す。図に示す ように、最終的に三層(CMSX-4/Mo/MoSi₂) からなる被覆系を形成することに成功した。 CMSX-4 と Mo 層の界面は比較的滑らかだが、 CMSX-4 側に若干のボイドが見られた。Mo 層の上に形成された MoSi₂ は櫛状の形態を 示し、若干の Mo が珪化されずに線状に残存 していた。

(2) 平滑かつ緻密な皮膜を形成できる条件の 探査

電気化学測定

FLiKにK₂MoO₄を1 mol%添加した浴でカ ソード分極してゆくと、約 -0.1 V から Mo(VI)イオンの還元電流が流れ始め、約 -0.2 V で拡散限界に伴う還元電流のピークが 観測された(図4)。電位走査を反転させると Moの酸化電流が観測された。一方で、FLiK に K₂B₄O₇を 0.5 mol%添加した浴でカソード 分極してゆくと、約 -0.5 V から B(III)イオン の還元電流が流れ始め、電位走査を反転させ ると、Bの酸化電流が観測された。つまり、 Mo イオンの方が還元電位が高いことがわか る。さらに、FLiK に K2MoO4 および K2B4O7 を添加した浴では、はじめに Mo イオンの還 元電流が流れるが、ピークは観測されず、電 位を下げるほど還元電流が増大した。このこ とから、Mo イオンだけでなく、B イオンも 部分的に還元されていると推察される。電位 走査を反転させると、Bの酸化電流は観測



図3 CMSX-4 カソード断面の SEM 像。 (a) Mo コーティングのための定電流電解後, 温度:1223 K,カソード電流密度:50 mA·cm⁻². (b) Mo 層の珪化のための定電流電解後,温 度:1073 K,カソード電流密度:30 mA·cm⁻².

されず、約0Vから Moの酸化電流が観測された。このことは還元析出したBが、即座に Moイオンを還元していることを暗示してい る。以上の結果から、B化合物を添加しない 浴でも Moイオンの還元(カソード反応)そ のものは起こることが、また、B化合物を添 加すると還元電流が増大することが分かっ た。



図4 1223 K における溶融 FLiK- K₂MoO₄ -K₂B₄O₇ 系でのサイクリックボルタモグラ ム.走引速度:200 mV·s⁻¹.

定電流電解による Mo 電析

FLiK-10 mol% K₂MoO₄ および FLiK-10 mol% K₂MoO₄-5 mol% K₂B₄O₇における電 解(カソード電流密度 10 mA cm⁻²)で得ら れたカソード断面の SEM 像を**図5**に示す。 B源を添加しない場合、電解後に回収した電 極には析出物が付着していたが、付着塩の洗 浄段階で電極から脱離した。脱離した析出物 を SEM で観察すると樹脂状晶であった(**図** 6)。また、電極上の Mo は粒子状に結晶成長 していることが確認された(**図5(a)**)。一方、 B源を添加した場合、Mo は柱状晶に成長し、 皮膜を形成していた(**図5(b)**)。

(a) No boron



(b) Boron addition



図 5 定電流電解後の Ni カソード断面の SEM 像. 電流密度: 10 mA cm⁻². 浴組成(a) FLiK- 10 mol% K₂MoO₄, (b) FLiK-10 mol% K₂MoO₄-5 mol% K₂B₄O₇. 実験後,電 極は H₂O₂--NH₃ aq.でエッチングした。



図 6 定電流電解後に Ni カソードから剥離 した析出物の SEM 像 .電流密度:10 mA cm⁻². 浴組成: FLiK-10 mol% K₂MoO₄.

つまり、Mo析出物が回収できるかどうかは、 生成した Moの結晶形態しだいとわかった。 カソード電流密度を 5~50 mA·cm⁻² に変化 させた電解での見かけの電流効率(脱離した Mo樹脂状晶は析出重量の勘定に入れない) を表に示す。B 源を添加しない場合、電流密 度を上げると見かけの電流効率が低下し、50 mA·cm⁻²では 4%と、ほとんど電極上に残ら ないことがわかった。これは、電流密度の増 大と共に樹脂状晶の発生が顕著になったた めである。一方で、B 源を添加した場合、電 流密度を上げても皮膜組織は柱状晶のまま で、見かけの電流効率は変わらず、ほぼ 100% であった。つまり、B 源の添加は樹脂状晶の 抑制に効果があると言える。

K₂B₄O₇ 濃度を 0.01, 0.1, 1, 5 mol%と変 えて 50 mA· cm⁻² で電解を行ったところ、見 かけの電流効率はそれぞれ 8.4, 33, 92, 95% となった。つまり、K₂B₄O₇ 濃度が増大する につれ、樹脂状晶の抑制が強くなり、1 mol% を越えると、ほぼ柱状晶になることがわかっ た。

B源を加えた電解によって得られた Mo皮 膜断面を SEM-EDX で分析したところ、僅か ではあるが B が検出された。このことは、 GD-OES でも確認された。そこで、Mo 皮膜 を硝酸で溶解し、得られた溶液を ICP-AES で分析したところ、皮膜中に B が最大で 0.46 mol%含まれていることがわかった。つまり、 Mo イオンだけでなく B イオンも同時に還元 されて、Mo 皮膜中に混入していることがわ かった。Mo中のBの固溶度は幾つかの報告 があり、共晶点(2448 K)で0.2~1.75 mol%、 1223 K では無視できるほど小さい。³⁾ B の存 在形態は明らかでないが、過飽和で Mo 中に 固溶しているか、Mo2B 等金属間化合物の微 小な結晶として Mo 中に分散していると考え られる。同じ Mo 皮膜を XRD で分析したと ころ、Moの標準パターンと比べて(200)面 のピークが大きくなっており、特定の結晶面 が配向していると考えられる。また、回折角 56°付近に不明のピークがあり、Mo中のB と関連している可能性がある。

以上より、電解浴に添加された B 化合物は Mo イオンと共に還元され Mo 中に混入し、 Mo の析出様式を樹脂状から柱状に変えるこ とで、Mo の皮膜を形成させる役割を果たし ていると考えられる。

参考文献

- K. Kawagishi, A. Sato, T. Kobayashi and H. Harada: *J. Japan Inst. Metals*, 69 (2005), 249-252.
- 2) I. Barin, Thermochemical Data of Pure Substances (VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, Germany, 1989)
- 3) B. Predel, LANDOLT-BORNSTEIN, Group IV: Macroscopic and Technical Properties of Matter, Volume 5 Phase Equilibria, Crystallographic and

Thermodynamic Data of Binary Alloys, Subvolume b (1992).

Mo 電析の見かけの電流効率^{a)}

Current density, $i / mA \cdot cm^{-2}$ Apparent current efficiency, ε (%) No B B addition 5 104 105 10 95 101 20 64 98 30 46 107 40 13 104 50 4 3 97					
$\begin{array}{c ccc} i/\text{mA}\cdot\text{cm}^{-2} & \text{efficiency, } \varepsilon (\%) \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$	Current density,	Apparent current			
No B B addition 5 104 105 10 95 101 20 64 98 30 46 107 40 13 104 50 43 97	$i / \text{mA} \cdot \text{cm}^{-2}$	efficiency, ε (%)			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		No B	B addition		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5	104	105		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10	95	101		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	20	64	98		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	30	46	107		
50 4 3 97	40	13	104		
	50	4.3	97		

a) Galvanostatic electrolysis at 1223 K in FLiK-10 mol% K_2MoO_4 and FLiK-10 mol% K_2MoO_4 -5 mol% $K_2B_4O_7$.

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計1件)

O. Takeda, Y. Hoshino, Y. Anbo, K. Yanagase, M. Aono, Y. Sato, "Viscosity of Molten Alkaline-earth Fluorides", Int. J. Thermophys., Vol. 36, No. 4 (2015), 648-657. (査読有) DOI: 10.1007/s10765-014-1828-5

[学会発表](計6件)

竹田修、井関千暁、星政義、朱鴻 民、溶融塩電解による Mo 電析とB化合 物添加効果、資源・素材学会平成28年度 春季大会、2016年3月28日~30日、東 京大学本郷キャンパス(東京) 井関 千暁、竹田 修、星 政義、朱 鴻民、 Moの溶融塩電析への B 化合物添加の影 響、資源素材学会 東北支部 平成 27 年度 秋季大会、2015年11月16日、東北大学 大学院環境科学研究科 Ecolab (仙台) 井関 千暁、竹田 修、星 政義、朱 鴻民、 溶融塩中での Mo 電析における B 化合物 添加の影響、第47回溶融塩化学討論会、 2015年10月28日~29日、神戸大学百 年記念館(神戸) O. Takeda, S. Yamanaka, M. Hoshi, Y. Sato. H. Zhu. Formation of Molybdenum Silicide via Molten Salt Electrolysis. 10th International Conference on Molten Salt Chemistry Technology & 5th and Asian Conference on Molten Salt Chemistry and Technology, June 10-14, 2015, Shenyang, China 竹田 修、山中 茂樹、星 政義、佐藤 讓、 朱 鴻民、溶融塩電解を用いた耐熱合金へ

の二珪化モリブデン被膜の形成、資源・ 素材学会平成 27 年度春季大会、2015 年 3月 27日~29日、千葉工業大学津田沼 キャンパス(千葉)

竹田 修、山中 茂樹、星 政義、佐藤 譲、 朱 鴻民、溶融塩電解を用いた珪化モリブ デン耐酸化被膜の形成、第46回溶融塩化 学討論会、2014 年 11 月 13 日~14 日、 かずさアカデミアホール(千葉)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 取得状況(計0件)

〔その他〕

ホームページ等 無

6 . 研究組織

(1)研究代表者
竹田 修(TAKEDA, Osamu)
東北大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:60447141